

2SB617, 617A/2SD587, 587A

PNP/NPN 三重拡散形シリコントランジスタ／

PNP/NPN SILICON TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR

低周波電力増幅用／Audio Frequency Power Amplifier

特 徴／FEATURES

- ・2点止めモールドパッケージである——→熱放散が良い。
Mold power transistor mounted by two bolts, → good thermal radiation.
- ・TO-3と同等の熱容量と破壊耐量である。——→SOA=60V, 1A, 1sec
- ・放熱器やプリント板への実装法の自由度が大きい。
- ・出力30～40W ($R_L = 8\ \Omega$) のオーディオアンプの出力段および安定化電源等に適する。

Suitable for output stages of 30 to 40 watts audio amplifiers and voltage regulators.

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	2SB617	2SB617A	2SD587	2SD587A	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-120		120		V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-100	-120	100	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5.0		5.0		V
コレクタ電流(直流)	I _{C(DC)}	-6.0		6.0		A
コレクタ電流(パルス)	I _{C(pulse)} *	-10.0		10.0		A
全損失	P _{T(T_C=25℃)}	70				W
ジャンクション温度	T _j	150				℃
保存温度	T _{stg}	-55~+150				℃

* $PW \leq 10\text{ms}$, duty cycle $\leq 50\%$

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

2SB617, 617A/2SD587, 587A

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100\text{V}$, $I_E=0$			-50/50	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3\text{V}$, $I_C=0$			-50/50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$ *	20	90/50		
	h_{FE2}	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=1\text{A}$ *	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.4\text{A}$ *		-0.7/0.5	-2.0/2.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.4\text{A}$ *		-1.1/1.0	-2.0/2.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=0.2\text{A}$		14/17		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$		220/130		pF

* パルス測定 $PW \leq 350\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ /Pulsed h_{FE2} 区分/ h_{FE2} Classification

S: 40～80 R: 60～120 Q: 100～200

上記電気的特性において電圧電流の極性を表記してありませんので、ご注意ください。/No polarity.